

2SB554

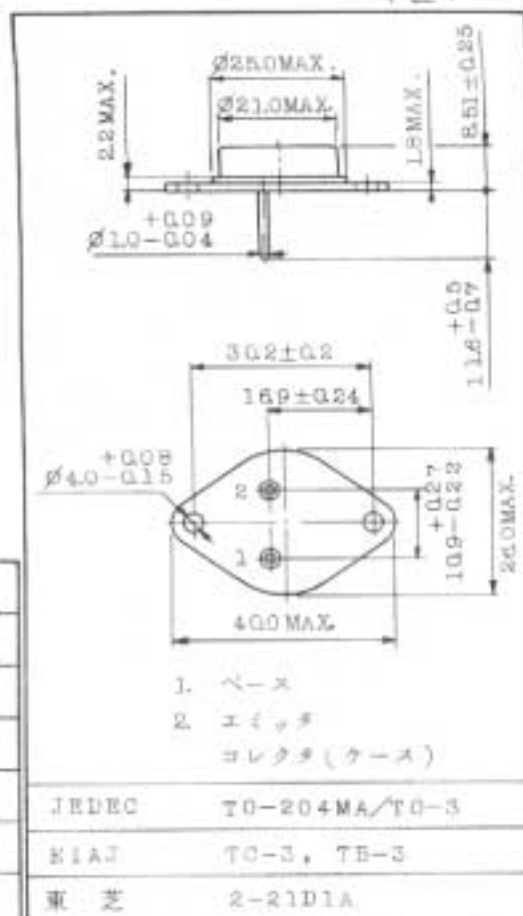
シリコンPNP三重拡散形トランジスタ

○ 電力増幅用

特長

- コレクタ損失が大きい。: $P_C = 150W$
- 高耐圧です。: $V_{CEO} = -180V$
- 2SD424 とコンプリメンタリになります。
- 100W ハイファイオーディオアンプ出力段に最適です。

単位: mm



アクセサリはAU73を適用

最大定格 ($T_a = 25^\circ C$)

項目	記号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-180	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-180	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-15	A
ベース電流	I_B	-1.5	A
コレクタ損失 ($T_c = 25^\circ C$)	P_C	150	W
接合温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-65~150	$^\circ C$

電気的特性 ($T_a = 25^\circ C$)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
コレクタしゅ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -90V, I_E = 0$	-	-	-100	μA
エミッタしゅ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$	-	-	-100	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -0.1A, I_E = 0$	-180	-	-	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = -10mA, I_C = 0$	-5	-	-	V
直電流増幅率	h_{FE} (注)	$V_{CE} = -5V, I_C = -2A$	40	-	140	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -10A, I_E = -1A$	-	-	-30	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE} = -5V, I_C = -10A$	-	-	-25	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = -5V, I_C = -2A$	-	6	-	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10V, I_E = 0, f = 1MHz$	-	450	-	pF

注: h_{FE} 分類 R: 40~80, O: 70~140